

Кремниевый фотодетекторный чип 1.42 мм — техническое описание

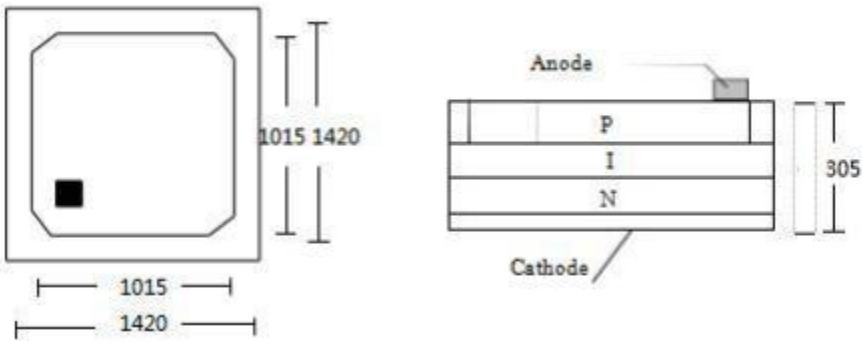
P/N : WS56-01C

Особенности

Si PIN фотодиодный чип

Структура

Планарная структура: PIN-диод;
электроды: задняя сторона (катод) —
сплав Au, верхняя сторона (анод) —
Al



ГАБАРИТЫ

Габариты	Тип.			Ед. изм.
Активная область	1015±20 x 1015±20			мкм
Ширина чипа	1420			мкм
Длина чипа	1420			мкм
Высота чипа	285	305	325	мкм
Размер контактной площадки	160 x 160			мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA, H=0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	Vbr	Ir=100μA, H=0	35			В
Обратный темновой ток	Id	Vr=10V			1	нА
Пиковая длина волны	λp		400	940	1100	нм
Емкость	Cj	VR=3V, f=1MHz		11		пФ